

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 1 区分
 【発行日】平成 26 年 4 月 3 日 (2014.4.3)

【公開番号】特開 2012-171831 (P2012-171831A)
 【公開日】平成 24 年 9 月 10 日 (2012.9.10)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-036
 【出願番号】特願 2011-34973 (P2011-34973)
 【国際特許分類】

C 0 3 C 15/00 (2006.01)

C 0 3 C 23/00 (2006.01)

G 0 2 F 1/1333 (2006.01)

【 F I 】

C 0 3 C 15/00 A

C 0 3 C 23/00 A

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 2 月 14 日 (2014.2.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体素子が形成されるフラットパネルディスプレイ用のガラス基板の製造方法であって、

半導体素子が形成されるガラス基板の半導体素子形成面と反対側のガラス表面を洗浄処理する工程と、

洗浄された前記ガラス表面にエッチング処理をする工程と、を有し、

前記エッチング処理された前記ガラス表面の R_a (原子間力顕微鏡により測定される表面凹凸の算術平均粗さ) が 0.3 (nm) 以上 1.0 (nm) 以下であって、 $R_z - R_{zjis}$ (R_{zjis} は原子間力顕微鏡により測定される表面凹凸の 10 点平均粗さであり、 R_z は原子間力顕微鏡により測定される表面凹凸の最大高さである) が 0.2 (nm) 以下になるように、前記ガラス表面の前記洗浄処理および前記エッチング処理が行われる、ことを特徴とするガラス基板の製造方法。

【請求項 2】

前記ガラス基板の洗浄処理は、大気圧プラズマ洗浄である、請求項 1 に記載のガラス基板の製造方法。

【請求項 3】

洗浄処理された前記ガラス基板のガラス表面における水の接触角度は、 10 度以下である、請求項 1 または 2 に記載のガラス基板の製造方法。

【請求項 4】

半導体素子が形成されるフラットパネルディスプレイ用のガラス基板であって、

ガラス基板の半導体素子形成面と反対側のガラス表面の R_a (原子間力顕微鏡により測定される表面凹凸の算術平均粗さ) が 0.3 (nm) 以上 1.0 (nm) 以下であって、 $R_z - R_{zjis}$ (R_{zjis} は原子間力顕微鏡により測定される表面凹凸の 10 点平均粗さであり、 R_z は原子間力顕微鏡により測定される表面凹凸の最大高さである) が 0.2 (nm) 以下である、ことを特徴とするガラス基板。